PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2003-289050

(43) Date of publication of application: 10.10.2003

(51)Int.CI.

H01L 21/26

C23C 16/44

H01L 21/205

H01L 21/22

(21)Application number: 2002-

(71)Applicant: HITACHI KOKUSAI

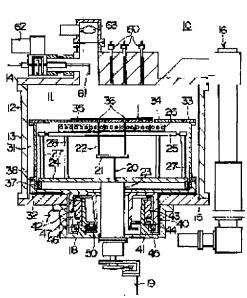
091899

ELECTRIC INC

(22) Date of filing:

28.03.2002 (72)Inventor: ITO TAKESHI

(54) SUBSTRATE TREATMENT DEVICE



(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent the generation of a dust from a suscepter rotating device or the failure of a rotational operation.

SOLUTION: An RTP device 10 is equipped with a treatment chamber 11 for housing a wafer 1, a suscepter 35 set in the treatment chamber 11 for holding the wafer 1, a first heating lamp group 25 and a second heating lamp group 26 for heating the wafer 1 held by the suscepter 35, and a suscepter rotating device 40 for rotating the suscepter 35. A brushless

On mater is used for the successor

DC motor is used for the suscepter rotating device 40, and a stator (fixer) 42 constituted of an electromagnet (coil) is fixed to the outer peripheral face of a yoke 41. A rotor 46 is disposed outside the stator 42 like a concentric circle with an air gap (clearance) set, and supported so as to be freely rotatable by a ball gearing 45. Therefore, it is possible to directly rotate the suscepter, and it is possible to omit a gear which generates dusts, vibration, and an abnormal sound and a bearing which causes a rotational failure depending on the level of fastening.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

17.03.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開發号 特開2003-289050 (P2003-289050A)

(43)公隔日 平成15年10月10日(2003.10.10)

(51) Int.CL?	織別記号	FI	ラーヤユード(参考)
HOIL 21/26		C 2 3 C 16/44	G 4K030
C 2 3 C 16/44		HO1L 21/205	5 F 0 4 5
HOIL 21/200	3	21/22	501R
21/22	5 0 1	21/26	Q
		審查商求 未商求 請求	- MAN OL (全 5 頁)
(21)出顯番号	特輯2002 −91899(P2002 −91899)	(71)出順人 000001122 株式会社日立国際電気	
(22)出願日	平成14年3月28日(2002.3.28)		立四級電效 区東中野三丁目14 番2 0号
(vec) trikki ti	- Mist a Menti Crown or rol	(72)発明者 伊藤 剛	keyke, Lind 1. Management
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	区束中野三丁目14番20号 株式
		会社日立国	
		(74)代理人 100085637	
		护理士 櫈	原 辰也
		Fターム(参考) 4K030	CA04 CA12 GA06 LA15
		58045	BBL5 0902 EK11 ENLO

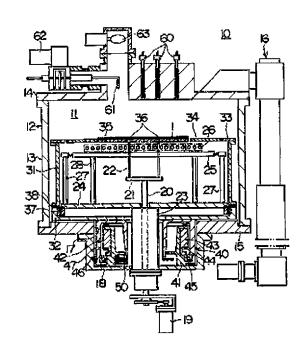
(54) 【発明の名称】 基板処理装置

(57)【要約】

【課題】 サセプタ回転装置からの発度や回転動作の不良を防止する。

【解決手段】 ウエハ1を収容する処理室11と、処理室11に設置されてウエハ1を保持するサセプタ35と、サセプタ35に保持されたウエハ1を加熱する第一加熱ランプ群26と、サセプタ35を回転させるサセプタ回転装置40とを備えたRTP装置10において、サセプタ回転装置40にはブラシレスDCモータが使用されており、ヨーク41の外国面には電磁石(コイル)によって構成されたステータ(固定子)42が固定され、ステータ42の外側にはロータ(回転子)46がエアギャップ(隙間)を設定されて同心円に配置され、ボールベアリング45を介して回転自在に支承されている。

【効果】 サセプタを直接的に回転駆動できるため、塵 埃、振動、異音が発生するギア、締め加減で回転不良を 発生するベアリングを省略できる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 被処理基板を収容する処理室と、この処 理室に設置されて前記物処理基板を保持するサセプタ と、このサセプタを回転させるサセプタ回転装置とを備 えている基板処理装置であって、前記サセプタ回転装置 はステータと、このステータの外側に陰間を介して配置 されて前記サセプタに連結されたロータとを備えている ことを特徴とする基板処理装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、基板処理装置に関 し、特に、基板を回転させる技術に係り、例えば、半導 体集積回路装置(以下、ICという。) の製造方法にお いて、半導体素子を含む集積回路が作り込まれる半導体 ウエハ(以下、ウエハという。) に成膜やアニール、酸 化膜成長および拡散等の各種の熱処理(thermal treatm ent)を施すのに利用して有効なものに関する。

[0002]

【従来の技術】【Cの製造方法において成膜やアニー ル、酸化膜成長および拡散等の各種の熱処理を経す基板 26 気口には処理室11を大気圧未満(以下、負圧とい 処理装置として、加熱源にタングステンーハロゲン直線 ランプ(以下、加熱ランプという。)を使用したRTP (Rapid Thermal Processing)装置がある。このRTP 装置は、彼処理基板としてのウエハを収容する処理室 と、この処理室においてウエハを保持するサセプタと、 サセプタ上のウエハをサセプタの下方から加熱する複数 本の加熱ランプと、処理室を大気圧よりも若干低めに排 気する緋気口と、ウエハを保持したサセプタを回転させ るサセプタ回転装置とを備えている。そして、とのRT てモータによって回転駆動されるようになっている。 100031

【発明が解決しようとする課題】しかし、前記したRT P装置においては、ギアおよびベアリングからバーティ クルが発生するという問題点や、ベアリングを固定する ための締め加減によって回転動作に不具合が発生して緩 動や異音が発生するという問題点がある。

【0004】本発明の目的は、サセプタ回転装置からの パーティクルの発生や回転動作の不良を防止することが できる基板処理装置を提供することにある。

[00005]

【課題を解決するための手段】本発明に係る基板処理装 置は、彼処理基板を収容する処理室と、この処理室に設 置されて前記被処理基板を保持するサセプタと、このサ セプタを回転させるサセプタ回転装置とを備えている基 板処理装置であって、前記サセプタ回転装置はステータ と、このステータの外側に隙間を介して配置されて前記 サセプタに連結されたロータとを備えていることを特徴 とする。

【0006】前記した手段によれば、ギア機構ねよびベー50 ランプ(タングステン-ハロゲン直線ランプ)が二十一

アリングを省略することができるため、回転動作の不良 を防止することができる。

[0007]

【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施の形態を図 面に即して説明する。

【①①08】図1に示されているように、本発明に係る 基板処理装置は、「Cの製造方法において成膜やアニー ル、酸化膜成長および拡散等の様々な熱処理に使用され る枚葉式コールドウオール形盒圧RTP装置(以下、R 10 TP装置という。)として構成されている。

【0009】図1に示されたRTP装置10は複処理基 板としてのウエハ!を処理する処理室11を形成した筐 体12を備えており、筐体12は上下面が開口した円筒 形状に形成されたカップ13と、カップ13の上面関口 部を閉塞する円盤形状のトッププレート!4と、カップ 13の下面関口部を閉塞する円盤形状のボトムプレート 15とが組み合わされて円筒中型体形状に機築されてい る。カップ13の側壁の一部には排気口(図示せず)が 処理室11の内外を連運するように開設されており、緋

う。) に排気し得る排気装置が接続されている。トップ プレート14はトッププレート開閉装置16によって開 閉されるように構成されている。彼処理基板としてのウ エハーはカップ 13の側壁の一部に設けられたウエハ鐵 入搬出口(図示せず)を経由して処理室11内に図示し ないウエハ移鉄装置(wafer transfer equipment)によ って搬入鐵出されるようになっている。

【0010】ボトムプレート15の中心線上には取付孔 17が大きく開設されており、ボトムプレート15の下 P装置のサセプタ回転装置においては、ギア機構を介し 30 面にはブラケット18が同心円に配置されて垂直方向下 向きに設置されている。ボトムプレート15の中心線上 にはブラケット18の下面に設置された昇降駆動装置! 9によって昇降駆動される昇降軸20が昇降自在に挿通 されてあり、昇降軸20の上端には昇降板21が水平に 固定されている。昇降板21の上面には複数本(通常は 三本または四本)のリフタビン22が垂直に立脚されて 固定されており、リフタビン22は昇降板21の昇降に 伴って昇降することによりウエハ1を下から支持して昇 降させるようになっている。

> 40 【0011】プラケット18の艦面における昇降軸20 の外側には、支持筒23が同心円に配置されて設置され ており、支持筒23の上端には冷却ブレート24が水平 に架設されている。冷却プレート24の上方には複数本 の創熱ランプから構成された第一加熱ランプ群25およ び第二加熱ランブ群26が下から順に配置されてそれぞ れ水平に架設されており、第一加熱ランプ群25および 第二加熱ランプ群26は第一支柱27および第二支柱2 8によってそれぞれ支持されている。第一加熱ランプ群 25および第二加熱ランプ群26は加熱源としての加熱

本(二十一本でなくてもよい。)、互いに平行に配列さ れて水平にそれぞれ架設されて構成されており、第一加 熱ランプ群25および第二加熱ランプ群26には四つの ゾーンが両端から中央にかけてそれぞれ設定されてい る。第一加熱ランプ群25 および第二加熱ランプ群26 は第一ゾーン〜第四ゾーン毎に制御器に並列に接続され ており、制御器は後記する温度計測器が接続されたコン トローラによってオントオフ制御されるように構成され ている。第一舰熱ランプ群25および第二加熱ランプ群 ラケット18の外部に引き出されるようになっている。 【0012】処理窒11には処理窒11の内径よりも小 径の外径の円筒形状に形成されたタレット31が同心円 に配置されており、タレット31は円形の皿形状に形成 された回転板32の上面に同心円に配置されて固定され ている。タレット31の上端には円形リング形状に形成 されたアウタブラットホーム33が水平に架設されてお り、アウタブラットボーム33の内側には小径の円形り ング形状に形成されたインナプラットホーム34が水平。 は炭化シリコンや窒化アルミニウム等が使用されて円板 形状に形成されたサセプタ35が、インナプラットホー ム34の上端開口を閉塞するように被せられている。サ セプタ35の各リフタピン22に対向する位置には挿通 孔36がそれぞれ関設されている。回転板32と冷却プ レート2.4 との間にはベアリング3.7 が介設されてお り、ベアリング37はベアリング押さえ具38によって 固定されている。回転板32はブラケット18に設置さ れたサセプタ回転装置40によって回転駆動されるよう になっている。

3

【0013】図2に示されているように、サセプタ回転 装置40にはブラシレスDCモータが使用されており、 支持衛23の外径よりも大径でブラケット18よりも小 径の円筒形状に形成されたヨーク41を値えている。ヨ ーク4!はブラケット18の底面の上に支持筒23と同 心円に配置されて緡え付けられており、ヨーク41の外 園面には電磁石(コイル)によって構成されたステータ (固定子) 4.2が固定されている。すなわち、ステータ 42はコイル線材(エナメル波覆銅線)44がコア(鉄 心) 43に巻続されて構成されており、ステータ42は 40 説明する。 ブラシレスDCモータのドライバ(図示せず)から電力 をコイル線材44にリード線を通じて供給されることに より、回転磁界を形成する界磁子を構成している。ステ ータ42の外側にはロータ(回転子) 46がエアギャッ プ(隙間)を設定されて同心円に配置され、ボールベア リング4.5を介して回転自在に支承されている。ロータ 46は円筒形状の本体47とコア48と複数個の永久磁 石49とを備えており、本体47の上面には回転級32 が一体回転するように固定されている。コア48は本体 4.7 に嵌合されて固定されており、コア4.8 の外層には 50 よって下降されることにより、リフタビン2.2 がサセブ

複数個の永久越石49が周方向に等間隔に固定されてい る。コア48と複数個の永久遊石49とによって環状に 配列された複数の磁極が形成されることにより、電機子 が構成されており、ステータ42の形成する回転磁界が 複数個の磁極の磁界を切ることにより、ロータ46が回 転するようになっている。

【0014】図2に示されているように、サセプタ回転 装置40には光学式ロータリーエンコーダ50が設置さ れている。すなわち、光学式ロータリーエンコーダ50 26の電力供給電線は支持筒23の中空部を挿道してブ 10 は薄い円板に多数本のスリットが放射状に関設されたス リット板51を備えており、スリット板51はロータ4 6の本体47に垂直方向下向きに突設されたブラケット 52に水平に固定されている。スリット板51の上側に は投光器53が配置されてステータ42に固定されてお り、スリット板51の下側には受光器54が配置されて ステータ42に固定されている。受光器54の検出結果 はブラシレスDCモータずなわちサセプタ回転装置40 のドライバに送信されて回転磁界の形成に使用されると ともに、サセプタ回転装置40のコントローラ(図示せ に架設されている。インナブラットホーム34の内側に 29 ず)の位置認識部に送信されてサセブタ35の位置認識 に使用される。

> 【0015】図1に示されているように、トップブレー ト14には温度計測器のプローブ60が複数本。互いに 半径方向にウエハ1の中心から周辺にかけてずらされて それぞれ配置されてウエハ1の上面と対向するように挿 入されており、温度計測器は複数本のプローブ60によ ってそれぞれ検出した温度計測結果をコントローラに逐 次送信するように構成されている。トッププレート14 の他の場所にはレファレンスセンサ61が設置されてお 39 り、レファレンスセンサ61はレファレンスセンサ用モ ータ62によって垂直面内で回転されるようになってい る。レファレンスセンサ61の上側にはレファレンスラ ンプ63がレファレンスセンサ61の先端に対向するよ うに設置されている。レファレンスセンサ6!は温度計 測器に光学的に接続されており、湿度計測器はウエハ1 からの光子密度とレファレンスランプ63から光子密度 とを比較することにより、計測温度を校正するようにな っている。

【りり16】次に、前記構成に係るRTP装置の作用を

【0017】カップ13の側壁に開設されたウエハ鍛入 鍛出口がゲートバルブにより関放されると、昇降軸20 が昇降駆動装置19によって上限位置に上昇されて、リ フタビン22がサセブタ35を下から挿通される。続い て、ウエハ移載装置によって鍛送されて来たウエハ1が 複数本のリフタビン22の上端間に受け渡される。その 後に、リフタビン22にウエハ1を受け渡したウエハ移 載装置は後退する。

【①①18】続いて、昇降軸20が昇降駆動装置19に

タ35の下方に引き込まれて、リフタビン22の上のウ エハ1がサセプタ35の上に受け渡される。ウエハ1が サセプタ35に受け渡されるとウエハ搬入銀出口がゲー トバルブにより閉じられる。処理室11が閉じられる。 と、処理室!1か緋気口を通じて緋気される。

5

【0019】また、ウエハ1がサセプタ35に受け渡さ れると、ウェハーをサセプタ35によって保持したタレ ット31が回転板32と共にサセプタ回転装置40によ って回転される。すなわち、サセプタ回転装置40が遅 数個の磁極の磁界を切ることにより、ロータ46が回転 するため、ロータ46の本体47に固定された回転板3 2が回転する。この際、光学式ロータリーエンコーダ5 ①によってロータ46の回転位置が時々刻々と検出され てドライバに送信され、この信号に基づいて回転磁界が 形成されるとともに、コントローラの指令によって回転 速度等が制御される。

【0020】サセプタ35に保持されたウエハ」はサセ プタ回転装置40によって回転されながら、第一加熱ラ ンプ群25 および第二加熱ランプ群26によって加熱さ 20 れる。この加熱中におけるウエハ1の温度は温度計測器 のプローブ60によって逐次計測され、コントローラへ 逐次送信されている。コントローラは温度計測器からの 計測結果に基づいてフィードバック制御を実行する。こ の際、レファレンスセンサ61からのデータに基づいて 温度の校正が実施される。

【0021】サセプタ35がサセプタ回転装置40によ って回転されながら、サセプタ35の上に保持されたウ エハ1は第一加熱ランプ群25ねよび第二加熱ランプ群 26によって匍熱されるため、ウエハ1は全面にわたっ 30 等の墓板であってもよい。 て均等に熱処理される。そして、熱処理レートはウエハ 1の温度分布に依存するため、ウエハ1の温度分布が全 面にわたって均一であれば、ウエハ1に施される熱処理 状況の分布はウエハ!の全面にわたって均一になる。

【① 022】予め設定された所定の処理時間が経過する と、処理室11は排気口によって所定の負圧に排気され る。続いて、前述とは逆の手順により、ウエハーはリフ タビン22によってサセプタ35から所定の間隔だけ浮 かされた後に、リフタピン22の上からウェハ移載装置 によってピックアップされ、処理室11の外部へ搬出さ 40 れる。

【10023】以降、前述した作業が繰り返されることに より、RTP装置10の枚葉処理が実施されて行く。

【0024】前記実施の形態によれば、次の効果が得ら

【() () 2.5 】 1) サセプタ回転装置をステータと、ステ ータの外側に隙間を介して配置されてサセフタに連結さ れたロータとから構成することにより、ステータによっ て回転磁界を形成してロータを回転させてサセプタを直 接的に回転駆動することができるため、パーティクルや「50」板、22…リフタピン、23…支持筒、24…冷却プレ

振動および異音が発生するギア、締め加減によって回転 動作に不具合を発生するベアリングを省略することがで きる。

【()()26】2) サセプタに連結されるロータの外径を 大きく設定することにより、ロータをフライボイールと して活用することができるため、バランスよく安定した 回転動作を創出することができる。

【0027】3) ステータをロータの内側に配置するこ とにより、中心付近における中空部の断面積を大きく設 転されると、ステータ42の回転磁界がロータ46の復 10 定することができるため、加熱ランプ群や他の機構部の 設置や配線および配管のレイアウトについての自由度を 高めることができる。

> 【①①28】4) サセプタの回転をサセプタ回転装置お よび光学式ロータリーエンコーダによって正確かつ精密 に副御することにより、回転速度のばらつきや回転むら の発生を防止することができるため、サセプタに保持さ れたウエハの面内の温度分布を全面にわたって均一に制 御することができ、その結果、熱処理状況の分布を全面 にわたってより一層均一に副御することができる。

【①①29】なお、本発明は前記実施の形態に限定され るものではなく。その要旨を逸脱しない範囲において、 種々に変更が可能であることはいうまでもない。

【①①30】例えば、ロータリーエンコーダは光学式の ものを使用するに限らず、磁気式のものを使用してもよ

【0031】匍熱源としては、加熱ランフを使用するに 限らず、抵抗線式ヒータ等を使用してもよい。

【0032】墓板はウエハに限らず、LCD装置(液晶 表示装置)の製造工程におけるガラス基板やアレイ基板

【りり33】前記実施の形態においては枚葉式コールド ウオール形為圧RTP装置に構成した場合について説明 したが、本発明は、減圧RTP装置やプラズマRTP装 置。ドライエッチング装置等の基板処理装置全般に適用 することができる。

[0034]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 サセプタ回転装置からのバーティクルの発生や回転動作 の不良を防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の形態であるRTP装置を示す. 正面断面図である。

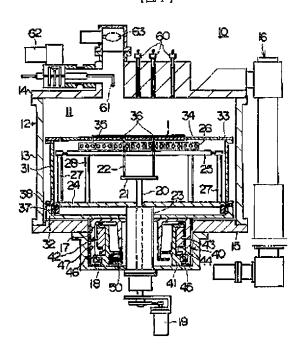
【図2】その主要部を示す正面断面図である。 【符号の説明】

1…ウエハ(墓板)、10…RTP装置(基板処理装 置) 11…処理室、12…筐体、13…カップ、14 …トッププレート、15…ボトムプレート、16…トッ フプレート関閉装置、17…取付孔、18…ブラケッ ト、19…昇降駆動装置。20…昇降軸、21…昇降

ート、25…第一加熱ランプ群、26…第二加熱ランプ * (エナメル被覆銅線)、45…ボールベアリング、46 群、27…第一支柱、28…第二支柱、31…タレッ ト、32…回転板、33…アウタブラットホーム、34 …インナプラットホーム、35…サセプタ、36…挿通 孔. 37…ベアリング、38…ベアリング押さえ具、4 ①…サセプタ回転装置、41…ヨーケ、42…ステータ (固定子)、43…コア(鉄心)、44…コイル線材 *

…ロータ(回転子)、4?…本体、48…コア、49… - 永久磁石、50…光学式ロータリーエンコーダ、51… スリット板、52…ブラケット、53…投光器、54… 受光器、60…プローブ、61…レファレンスセンサ、 62…レファレンスセンサ用モータ 63…レファレン スランプ。

【図1】



[図2]

